








	<h2 style="color: red;">SPD30N03S2L10GBTMA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPD30N03S2L10GBTMA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p> <p>Datenblätter:  SPD30N03S2L10GBTMA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPD30N03S2L10GBTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 50µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1550pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SPD30N03S2L10GBTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD30N03S2L10GBTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD30N03S2L10GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPD30N03S2L10GBTMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPD30N03S2L-20 G I SPD30N03S2L-20 G I</p>	 <p>SPD30N03S2L-20G VB SPD30N03S2L-20G VB</p>	 <p>SPD30N03S2L20GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>	 <p>SPD30N03S2L-20 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A DPAK</p>
 <p>SPD30N06S2L-13 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A DPAK</p>	 <p>SPD30N06S2-23 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A DPAK</p>	 <p>SPD30N03S2L10T Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A DPAK</p>	 <p>SPD30N03S2L07GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPD30N03S2L10GBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD30N03S2L10GBTMA1 Datenblatt	SPD30N03S2L10GBTMA1-Datenblätter	SPD30N03S2L10GBTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies)
SPD30N03S2L10GBTMA1 Electronic	SPD30N03S2L10GBTMA1-Komponenten	SPD30N03S2L10GBTMA1-Verteiler	SPD30N03S2L10GBTMA1-Bild	SPD30N03S2L10GBTMA1
SPD30N03S2L10GBTMA1 Aktie	SPD30N03S2L10GBTMA1 Inventar	SPD30N03S2L10GBTMA1 Preis	SPD30N03S2L10GBTMA1 Hersteller	SPD30N03S2L10GBTMA1-Teil
SPD30N03S2L10GBTMA1 RFQ	SPD30N03S2L10GBTMA1 Online bestellen	SPD30N03S2L10GBTMA1 Neu	SPD30N03S2L10GBTMA1 Original	SPD30N03S2L10GBTMA1 Bild
				SPD30N03S2L10GBTMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited